Projekt z Elektroniki

SERIA 7A

2012-01-02

Definicja problemu

PROJEKT Z ELEKTRONIKI

rok akad. 2011/2012

W zadaniach rozwiązywanych komputerowo należy stosować modele elementów opisane w bibliotece EVAL.LIB.programu PSpise Eval.6.2

[1] PCSpise Evaluation Center - Micro-Sim VER. 6.2

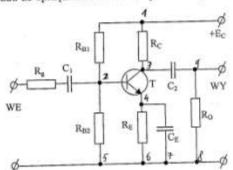
[2] J. Porębski, P. Korohoda: SPICE – program analizy nieliniowej układów elektronicznych, WNT, Warszawa 1992.

[3] A. Chwaleba, B. Moeschke, G. Płosajski: Elektronika, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.

[4] Praca zbiorowa pod red. A. Filipkowskiego: Projektowanie i laboratorium z "Elementów i układów elektronicznych" Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.

Zadanie 1. Stosując program PSpise wykonaj wykresy statycznych charakterystyk wejściowych i wyjściowych tranzystora n-p-n Q2N2222, dla układu ze wspólnym emiterem (WE). Analizę wykonaj dla temperatury ; tj=25 °C, w zakresie zmian prądu bazy w przedziale 0 - 120 μA, ze skokiem 10 μA.

Zadanie 2. Wykonaj projekt wzmacniacza jednostopniowego w układzie WE dla małych amplitud i 3-dB zakresu częstotliwości: f_d=15 Hz, f_g=20 kHz. Przyjmij napięcie zasilające Ec = 12 V. Określ wartości rezystorów RBI, RB2, RC i RE oraz pojemności: C1, C2, i Cg dla układu ze sprzężeniem emiterowym i tranzystorem Q2N2222 (jak na rys.). Oblicz uzyskane



wzmocnienia Ku i Ki oraz rezystancję wejściową rwe i wyjściową rwy. Obliczenia wykonaj dla rezystancji obciążenia Ro= 8,2 kΩ i rezystancji wewnetrznej $R_0 = 3.3 \text{ k}\Omega$.

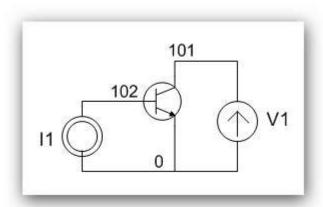
Obliczenia bez użycia komputera dokonaj przy założeniu rbb= 0 oraz $h_{22} = 1/r_{ce} = 0$. Dobór punktu pracy tranzystora na charakterystykach uzyskanych w Zad.1.

Zadanie 3. Wykonaj analizę projektu z Zad.2, stosując program PSpise. Porównaj uzyskane wyniki obliczeń uwzględniając przy porównaniu fakt zastosowania uproszczonych danych w Zad.2.

Zadanie 1

Stosując program PSpise wykonaj wykresy statycznych charakterystyk wejściowych i wyjściowych tranzystora n-p-n Q2N2222, dla układu ze wspólnym emiterem (WE). Analizę wykonaj dla temperatury: $t_j=25$ °C, w zakresie zmian prądu bazy w przedziale 0-120 μ A, ze skokiem 10 μ A.

Charakterystyka tranzystora bipolarnego n-p-n 2N2222



rys. 1

Charakterystyki wejściowa i wyjściowa w programie PSPICE

ZAD 1 WEJSCIE.

Q1 101 102 0 Q2N2222 VIN 102 0 VZAS 101 0 DC 0

.DC VIN 0 0.84 0.01

.LIB eval.lib .model Q2N2222 npn .TEMP 25 .PROBE .end ZAD 1 WYJSCIE.

Q1 101 102 0 Q2N2222 IIN 0 102 VZAS 101 0

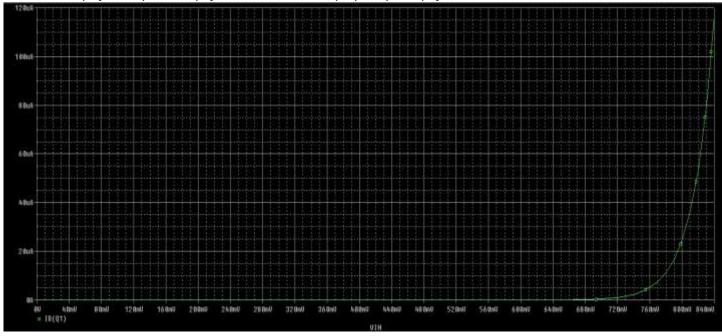
.DC VZAS 0 12 0.01 IIN 0 120u 10u

.LIB eval.lib .model Q2N2222 npn .TEMP 25 .OP .PROBE .end

Statyczna charakterystyka tranzystora n-p-n Q2N2222

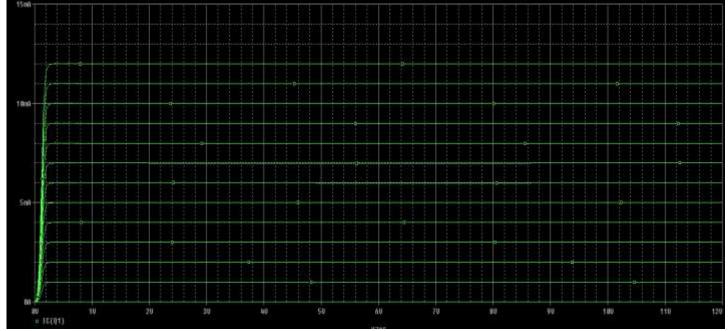
Charakterystyka wejściowa

Zależność prądu bazy IB od napięcia baza-emiter UBE, przy stałym napięciu kolektor-emiter UCE.



Charakterystyka wyjściowa

Zależność prądu kolektora I_C od napięcia kolektor-emiter U_{CE} przy doprowadzonym napięciu wejściowym baza-emiter U_{BE} i stałym prądzie bazy I_B .



Wnioski

Z wykresu charakterystyki wejściowej odczytać można, że do napięcia o wartości około 0,7V prąd jest znikomy. Po przekroczeniu tej wartości następuje gwałtowny wzrost natężenia prądu przy nieznacznym wzroście napięcia.

Na podstawie wykresu charakterystyki wyjściowej można stwierdzić iż powyżej pewnego napięcia (około 0,25V) prąd kolektora prawie nie zależy od napięcia U_{CE}

Zadanie 2

Wykonaj projekt wzmacniacza jednostopniowego w układzie WE dla małych amplitud i 3-dB zakresu częstotliwości: f_d =15Hz, f_g =20kHz. Przyjmij napięcie zasilające E_c =12V. Określ wartości rezystorów R_1 , R_2 , R_C i R_E oraz pojemności: C_1 , C_2 , i C_E dla układu ze sprzężeniem emiterowym i tranzystorem Q2N2222. Oblicz uzyskane wzmocnienia K_u i K_i oraz rezystancję wejściową r_{WE} i wyjściową r_{WY} . Obliczenia wykonaj dla rezystancji obciążenia R_0 =8,2k Ω i rezystancji wewnętrznej R_g =3,3k Ω . Obliczenia bez użycia komputera dokonaj przy założeniu r_{bb} =0 oraz h_{22} =1/ r_{ce} =0. Dobór punktu pracy tranzystora na charakterystykach uzyskanych w zadaniu 1.

Na podstawie charakterystyki wyjściowej wybieram punkt pracy (charakterystyka w załączeniu)

 I_{CQ} =8mA, U_{CEQ} =2,5V, I_{B} =50 μ A.

Obliczam rezystancję Rc i RE

 $R_C + R_E = (U_C - U_{CEQ})/I_{CQ}$

 $R_c + R_E = (12V-6V)/5mA = 1,2k\Omega$

Przyjmuję, że U_E =20%* U_C U_E =0,2*12V=2,4V

Przyjmuję, że $I_E=I_{CQ}$ $I_E=I_{CQ}=5$ mA

 $R_E = U_E / I_E = 2.4 V / 5 mA = 480 \Omega$

 $R_c=1,2k \Omega-480 \Omega=720\Omega$

Obliczam rezystancję R₁ i R₂

Przyjmuję, że $I_d=10*I_B$ (I_d - prąd płynący przez dzielnik)

 $I_B=50\mu A$

 $I_d = 500 \mu A$

Z prawa Ohma

 $R_1 + R_2 = E_C/I_d$

 $R_1 + R_2 = 12V/500\mu A = 24k\Omega$

dodatkowo:

 $R_2/(R_1 + R_2) = U_{R2}/E_C$

 $U_{R2} = U_{BE} + U_{E}$

 $U_{R2}=0,7V+2,4V=3,1V$

zatem

 $R_2 = U_{R2}*(R_1 + R_2)/E_C$

 $R_2=(1,9V/12V)*24k\Omega=3,8k\Omega$

 $R_1=24k\Omega-3.8k\Omega=20.2k\Omega$

Obliczam rezystancję rwe

Obliczam współczynnik wzmocnienia ß

 $I_B = I_{CQ}/\beta$

 $\beta = 5 \text{ mA} / 50 \mu \text{A} = 100$

Obliczam rezystancję wejściową tranzystora (h_{11e})

Przyjmuję, że U_T (potencjał elektrokinetyczny w temp 300K) wynosi 26mA

 $h_{11e}=U_T/I_B$

 h_{11e} =26mA/50 μ A=520 Ω

Obliczam rezystancję rwe

 $r_{we} = R_B | | h_{11e}$

 $r_{we} = (R_B * h_{11e}) / (R_B + h_{11e})$, gdzie $R_B = (R_1 * R_2) / (R_1 + R_2) = (20.2 k\Omega * 3.8 k\Omega) / (20.2 k\Omega + 3.8 k\Omega) = 3.2 k\Omega$

więc r_{we} =(3,2kΩ*0,52 kΩ)/ (3,2kΩ+0,52 kΩ)=450Ω

Obliczam pojemności C1, C2 i CE

Pojemności C1, C2 i CE tworzą filtry dolnoprzepustowe

Obliczam C₁

 $f_d=1/(2*\prod^*R_{C1}*C_1)$, gdzie $R_{C1}=R_g+r_{WE}$

 R_{C1} =3,3 $k\Omega$ +450 Ω =3,75 $k\Omega$

 $C_1=1/(2*3,14*3,75k\Omega*15Hz)=2,8\mu F$

Obliczam C₂

 $f_d=1/(2*\prod *R_{C2}*C_2)$, gdzie $R_{C2}=R_C+R_0$

 R_{C2} =720 Ω +8,2 $k\Omega$ =8,92 $k\Omega$

 $C_2=1/(2*3,14*8,92k\Omega*15Hz)=1,2\mu F$

Obliczam C_E

 $C_E = (\beta + 1) / [2* \prod * f_d * (R_g + h_{11e})]$

 $C_E = 101/[2*3,14*15Hz*(3,3k\Omega+520\Omega)] = 280\mu F$

Obliczam rezystancję rwy

 $r_{WY} \approx R_c = 720\Omega$

Obliczam ku i ki

 $k_u = (R_c * R_0) / (R_c + R_0) * \beta * (1/h_{11e}) = (720\Omega * 8,2k\Omega) / (720\Omega + 8,2k\Omega) * 100 * (1/520\Omega) = 127,28V/V$

 $k_i = [R_C/(R_C + R_0)] * \beta * [R_B/(R_B + h_{11e})] = [720\Omega/(720\Omega + 8,2k\Omega) * 100 * [3,2k\Omega/(3,2k\Omega + 520\Omega)] = 6,94A/A$

Podsumowanie obliczonych wartości:

 $R_1 = 20,2k\Omega; \quad R_2 = 3,8k\Omega; \quad R_C = 720\Omega; \quad R_E = 480\Omega; \quad C_1 = 2,8\mu F; \quad C_2 = 1,2\mu F; \quad C_E = 280\mu F; \quad K_u = 127,28V/V; \quad K_i = 6,94A/A; \quad r_{WE} = 450\Omega; \quad r_{WY} = 720\Omega$

Zadanie 3

Wprowadzenie i przetestowanie obliczonych danych z użyciem programu PSPICE.

Plik wejściowy

ANALIZA WZMACNIACZA W UKLADZIE WE Z TRANZYSTOREM Q2N2222

.LIB EVAL.LIB

VIN 11 0 AC 1

RG 1 11 3.3K

R1 33 2 20.2K

R2 2 0 3.8K

RC 33 4 720

RE 3 0 480

C1 2 1 2.8U

C2 4 5 1.2U

CE 3 0 280U

RO 5 0 8.2K

VZAS 33 0 DC 12V

Q1 4 2 3 Q2N2222

.OP

.AC DEC 10 15 20K

.MODEL Q2N2222 npn

.TRAN 2U 2M

.TEMP 25

.PROBE

.END

Wyniki w pliki wyjściowym *.out po wykonanej analizie

```
MODEL
          Q2N2222
ΙB
      2.14E-05
IC
       2.14E-03
VBE
        7.96E-01
VBC
       -8.63E+00
VCE
        9.43E+00
BETADC
          1.00E+02
GM
        8.31E-02
RPI
       1.20E+03
RX
       0.00E+00
RO
       1.00E+12
       0.00E+00
CBE
CBC
        0.00E+00
CJS
       0.00E+00
BETAAC
         1.00E+02
CBX/CBX2 0.00E+00
FT/FT2
         1.32E+18
```

Q1

NAME

Informacje

Podczas robienia projektu korzystałem z następujących źródeł:

- 1. "Elementy i układy elektroniczne. Projekt i laboratorium" pod red. Andrzeja Filipkowskiego, wydanie 2, OWPW, Warszawa, 2007
- 2. "Podstawy elektroniki" części 1 i 2, Barbara Pióro i Marek Pióro, wydanie 2, WSIP, Warszawa, 1997
- 3. "Odbiorniki radiowe", Henryk Chaciński, WSIP, 1980, Warszawa
- 4. Forum poświęcone elektronice www.elektroda.pl